

K1307CK1Y-

Схема защиты входных и выходных цепей РЭА от импульсных перегрузок

Условное графическое изображение

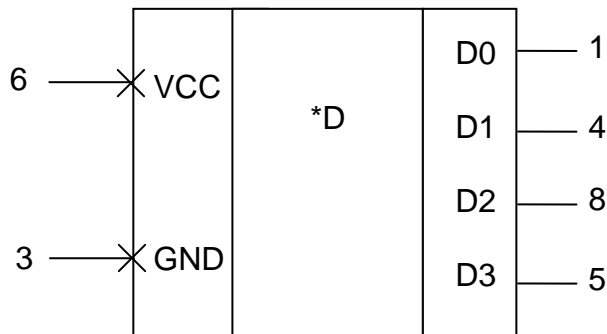


Таблица назначения выводов

Номера выводов	Обозначение	Назначение
1	D0	Вход/Выход «Данные», разряд 0
2	–	Не используется
3	GND	Общий
4	D1	Вход/Выход «Данные», разряд 1
5	D3	Вход/Выход «Данные», разряд 3
6	VCC	Питание
7	–	Не используется
8	D2	Вход/Выход «Данные», разряд 2

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Н О Р М А	
		не менее	не более
Напряжение питания, В	U_{CC}	0	15
Напряжение на входе, В	U_I	U_{SS}	U_{CC}
Максимальный импульсный ток через любой вывод, А	I_D	–	1,2*
Рабочий диапазон температур, °С	T_A	-60	85
Импульсная рассеиваемая мощность**, Вт	P_{TOT}	–	25

Примечания:
 1 * максимальный импульсный ток через любой вывод установлен при воздействии кратковременной перегрузки на входах величиной не более $U_{CC} + 5,0$ В и не менее минус 5,0 В.
 2 ** форма импульса – убывающая экспонента с параметрами: $\tau_{I(0,5)} = 20$ мкс, $\tau_{\Phi} = 8$ мкс.

Электрические параметры в диапазоне рабочих температур

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма параметра		Температура среды (корпуса), °С
		не менее	не более	
Напряжение на выводе U_{CC} , В	U_{CC}	-5	–	25 ± 10
Выходное напряжение высокого уровня на выводах D0-D3, В, при $I_{OH} = 1,0$ А*, $U_{CC} = 0$ В	U_{OH}	–	5	25 ± 10
Выходное напряжение низкого уровня на выводах D0-D3, В, при $I_{OL} = -1,0$ А*, $U_{CC} = 0$ В	U_{OL}	-5	–	25 ± 10
Ток потребления, мкА, при $U_{CC} = 15,0$ В	I_{CC}	–	10	25 ± 10
			100	85 ± 3 -60 ± 3
Входной ток высокого уровня, мкА, при $U_{CC} = 15,0$ В, $U_{IH} = 15,0$ В	I_{IH}	–	1	25 ± 10
			10	85 ± 3 -60 ± 3
Входной ток низкого уровня, мкА, при $U_{CC} = 15,0$ В, $U_{IL} = 0$ В	I_{IL}	–	1	25 ± 10
			10	85 ± 3 -60 ± 3

Примечание – * форма импульса - убывающая экспонента с параметрами: $\tau_{I(0,5)} = 20$ мкс, $\tau_{\Phi} = 8$ мкс.

Дополнительные данные:

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Значение собственной резонансной частоты микросхем 20 кГц.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °С с продолжительностью не более 4 с.